форм	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				<u>Документация</u>		
A3			ИУ4.11.03.03.23.05.52.04.001 СБ	Сборочный чертеж		
A3			ИУ4.11.03.03.23.05.52.04.001 Э1	Схема электрическая	1	
				структурная		
A3			ИУ4. 11.03.03.23.05.52.04.001 ЭЗ	Схема электрическая	1	
				принципиальная		
A3			ИУ411.03.03.23.05.52.04.001 ПЭЗ	Перечень элементов	1	
A3			ИУ4.11.03.03.23.05.52.04.001 ПД1	Сравнение моделирования и экспериментальных данных	1	
			ИУ4.11.03.03.23.05.52.04.002 ПП	Плата печатная	1	
				Детали		
A3		1 N94.11.03.03.23.05.52.12.002		Плата печатная	1	
,,,		•	73 7.71.03.03.23.03.32.72.002	Радиатор HS 185-70 (Китай)	2	
				<u>Диоды</u>		
		2		15SQ045 (Dongguan YFW, Kumaū)	2	VD2, VD3
		3		1N4 002	1	VD1
				(Diotec Semiconductor, Германия)		
				W 3		
				<u>Конденсаторы</u>		
		4		K10-176 X5R 1000πΦ 50B ±10%	1	<i>[4</i>
		5		(Murata Electronics, Япония) K10-17Б X5R 220пФ 50В ±10%	1	<u>[1</u>
				(Murata Electronics, Япония)		
	\vdash	6		K73-17 0,68mκΦ 250B ±5%	1	<i>Ε7</i>
				(Кузнецкий завод конденсато- ров, Россия)	,	
				ИУ4.11.03.03.23.05.52.04	4.00	1
Изм Ра	Лии зраб	-+	№ докум. Подп. Дата акулевский	Исилитоли Лит.	Лист	Листов
Пр		_	эменцов С. Г.	- Усилитель — ——————————————————————————————————		3

Н.контр. Уп р .		D.			Спецификация МГТУ им Н. Э. Бау. Кафедра ичч		_	7	
форм	Зона	Поз.	Обознач	ение	Наименование	нование		Примеч.	
		7			K50-35 2200mκΦ 35B ±20%		2	<i>[6, [8</i>	
					(JB Capacitors, Гонконг)				
		8			К50-35 мини 47мкФ 50Е	3 ±5%	2	C2, C5	
					(JB Capacitors, Гонконг)				
		9			K50-35 100mκΦ 63B ±5%		1	<i>[3</i>	
					(JB Capacitors, Гонконг)	l			
					<u>Разьёмы</u>				
		10			Гнездо стерео 3,5мм S7	T-025	1	XS1	
					(Dragon City Industries,	Κυπαῦ)			
		11			Клеммник разъёмный 15 3.81–03Р (Degson, Kumau		1	XP1	
		12			Клеммник разъёмный 15. 3.81-02P (Degson, Kumau		1	XP2	
					<u>Резисторы</u>				
		13			CF-25 0,25Вт 4.7кОм ±5	%	2	R14, R15	,
					(Тайвань)				
		14			CF-25 0,25Вт 680Ом ±5	%	2	R3, R5	
					(Таūвань)				
		15			CF-25 0,25Вт ЗкОм ±5%	ź	2	R12, R13	?
					(Таūвань)				
		16			CF-25 0,25Bm 20k0m ±5	%	1	R11	
					(Тайвань)				_
		17			CF-25 0,25Bm 1,2k0m ±5	%	1	R7	
					(Тайвань)				
		18			CF-25 0,25Вт 2кОм ±5%	ź	1	R14	
					(Тайвань)				
		19			CF-100 1Bm 100m ±5%		1	R18	
					(Таūвань)				
				ИУ	4. 11.03.03.23.05.	52.04	.001	<i>1</i>	
Изм	Лис		№ докум. Подп. Д	ата					-

форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.	
		20		CF-100 1Bm 15x0m ±5%		R4	
				(Тайвань)			
		21		SQP 5Bm 0,10m ±5%	2	R16, R17	
				(Тайвань)			
		22		3296W-1-1-2LF 0,25Вт 1кОм ±20% (Bourns, США)	1	RP1	
				<u>Транзисторы</u>			
		23		BC546B	3	VT3, VT4, VT6	
				(Diotec Semiconductor, Германия)			
		24		BC556B	3	VT1, VT2, VT5	
				(Diotec Semiconductor, Германия)			
		25		IRF540NPBF	1	VT7	
				(Infineon Technologies, Германия)			
		26		IRF9540NPBF	1	VT8	
				(Infineon Technologies, Германия)			
	N94. 11.03.03.23.05.52.04.001						
Изм							